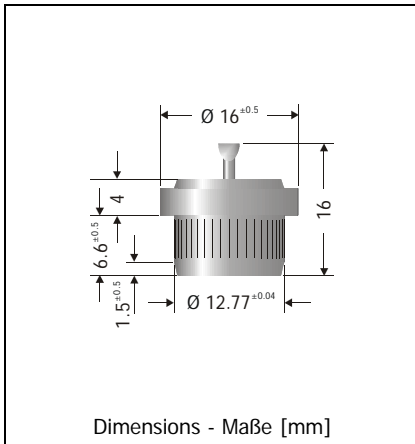


KYZ25A05 ... KYZ25A6, KYZ25K05 ... KYZ25K6

**Silicon-Press-Fit-Diodes – High Temperature Diodes
Silizium-Einpress-Dioden – Hochtemperatur-Dioden**

Version 2006-04-20



Nominal Current 25 A
 Nennstrom
 Repetitive peak reverse voltage 50 ... 600 V
 Periodische Spitzensperrspannung
 Metal press-fit case with glass seal
 Metall-Einpressgehäuse mit Glas-Durchführung
 Weight approx. – Gewicht ca. 10 g
 Compound has classification UL94V-0
 Vergussmasse nach UL94V-0 klassifiziert
 Standard packaging: bulk
 Standard Lieferform: lose im Karton



Maximum ratings

Grenzwerte

Type / Typ Wire to / Draht an		Repetive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
Anode	Cathode		
KYZ25A05	KYZ25K05	50	60
KYZ25A1	KYZ25K1	100	120
KYZ25A2	KYZ25K2	200	240
KYZ25A3	KYZ25K3	300	360
KYZ25A4	KYZ25K4	400	480
KYZ25A6	KYZ25K6	600	700

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_C = 150^\circ\text{C}$	I_{FAV}	25 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15\text{ Hz}$	I_{FRM}	90 A ¹⁾
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	270/300 A
Rating for fusing, $t < 10\text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10\text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	375 A ² s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s	-50...+175°C -50...+175°C

1 Max. case temperature $T_C = 150^\circ\text{C}$ – Max. Gehäusetemperatur $T_C = 150^\circ\text{C}$

Characteristics
Kennwerte

Forward Voltage Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 25\text{ A}$	V_F	$< 1.1\text{ V}$
Leakage Current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$	I_R	$< 100\ \mu\text{A}$
Thermal Resistance Junction – Case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse		R_{thc}	$< 1\text{ K/W}$

